台灣積體電路製造股份有限公司 FAB14B 廠 含氟及 N_2O 溫室氣體破壞處理設備排放減量 專案計畫書

版本: 第八版 製作日期:109/12/1

專案活動所屬之方案型專案	□ 本專案活動屬方案型專案之子專案
	■ 不適用
申請單位	台灣積體電路製造股份有限公司 FAB14B 廠
引用的減量方法和其範疇別	半導體產業含氟及 N ₂ O 溫室氣體破壞處裡設
	備排放減量方法學
	04 製造工業
	11 來自鹵化物和氟硫製造程序之逸散
年平均減量/移除量估計值	261,630 公噸 CO ₂ e

目錄	1
一、專案活動之一般描述	3
(一)專案名稱	3
(二)專案參與機構描述	3
(三)專案活動描述	3
(四)專案活動之技術說明	8
二、減量方法適用性及外加性分析描述	10
(一)專案活動採用之減量方法	10
(二)適用條件與原因	10
(三)專案邊界內包括的排放源和氣體	13
(四)基線情境之選擇與說明	13
(五)外加性之分析與說明	14
三、減量/移除量計算說明	16
(一)減量/移除量計算描述	18
(二)減量/移除量計算	
(三)計入期計算摘要	29
四、監測計畫	30
(一)應被監測之數據與參數	30
(二)抽樣計畫	30
(三)監測計畫其他要素	34
五、專案活動期程描述	34
(一)專案活動執行期間	34
(二)專案計入期	
六、環境衝擊分析	35
上、八甲辛日孙兴	26
七、公眾意見描述	30
附件一、參與機構基本資料	37
附件二、處理設備設計規範	38
附件三、補充第四章、監控計畫	53

附件四	•	尾氣破壞設備(LSC)成本	54
附件五	•	公眾意見訪談問題	55
附件六	•	無環評要求之證明	56
附件七	•	未裝設尾氣破壞設備(LSC)仍符合排放標準	57

台灣積體電路製造股份有限公司 FAB14B 廠含氟及 N₂O 溫室氣 體破壞處理設備排放減量專案計畫書

一、專案活動之一般描述

(一)專案名稱:台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱台積電)FAB14B 廠含氟及 N₂O 溫室氣體破壞處理設備排放減量專案

1. 版本與修訂紀錄:

版本	日期	修訂內容摘要
第一版	108年8月6日	初版
第二版	108年8月30日	依確證發現修訂
第三版	108年9月20日	依確證發現修訂
第四版	109年3月25日	依申請文件審查意見修正
第五版	109年5月29日	依第一次環保署審查意見修正
第六版	109年7月9日	依第二次環保署審查意見修正
第七版	109年9月29日	依環保署審查意見修正
第八版	109年12月1日	依環保署審查意見修正計入期

- 2. 減量方法範疇別:類別"4"製造工業、類別" 11" 來自鹵化物及氟硫化物製造和使用之逸散。
- 3. 含氟(fluorinated compounds, FCs)及 N₂O 溫室氣體。其中含氟溫室氣體包含 CF₄、C₄F₈、CH₅F₂、CH₃F、NF₃和 SF₆。

(二)專案參與機構描述:

本計畫書所指 FAB14B 包含 14B 廠(管制編號 D9000746)與 14B 廠七期(管制編號 D9001396)。

參與機構名稱	多與單位性質	角色說明
台灣積體電路製造股份有限公司14B廠	私人企業	專案規劃與執行者
台灣積體電路製造股份有限公司14B廠七期	私人企業	專案規劃與執行者
台灣積體電路製造股份有限公司	私人企業	投資者

(三)專案活動描述:

1.專案活動目的:

氣候變遷衝擊全球環境生態以及人類生活,在巴黎氣候協定生效後,各國更加 確定因應氣候變遷是全人類刻不容緩的當務之急。台積公司在「企業社會 責任政策」 及「環境保護政策」中,明白宣示因應氣候變遷是公司永續經營的責任,未來除持續關注氣候變遷的趨勢、國際與我國政府應變方向的變化。台積公司長期在節能減碳上努力持續精進,持續以達到產業標竿為目標。半導體行業含氟氣體是半導體製程溫室氣體最主要的直接排放源,超過直接排放量的八成,台積公司以製程氣體用量最佳化、執行低溫室潛勢氣體替代與安裝尾氣削減設備,做為降低直接排放的等標竿行動為主軸。民國 106 年,台積公司含氟氣體單位排放量與絕對排放量均較前一年大幅下降,單位排放量與基準年民國 99 年相比,降幅達 6%,成功達到公司年度目標,且遠超過世界半導體協會(WSC)所訂定的「2020 年全氟化物全球自願減量目標」

台積電 FAB14B 廠於民國 100 年開始採用污染防制的觀念,進行含氟及 N_2O 溫室氣體的使用減量排放,進行安裝尾氣處理設備降低含氟及 N_2O 溫室氣體的排放。這些活動的減量工作,其績效卓著。但欲持續保持這些排放減量的績效,仍需要投入額外的維護設備,始能維持低排放率的含氟及 N_2O 溫室氣體。如何維持這些減量成果,為本計畫執行的重點。

2.專案活動地點:

(1)相關地理位置如下圖。





台灣積體電路製造股份有限公司 FAB14B 廠 (包含 FAB14B 與 FAB14B 七期) FAB14B 地址:台南市善化區南科九路 17 號

專案執行邊界(實施前)

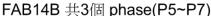
- 範疇為半導體製程中,含有含氟及N₂O溫室氣體使用排放為計畫邊界
 - 基線邊界示意 使用在蝕刻、化學/物理氣相沉積、薄膜及擴散製程共690台機台,排出製程使 用完後之尾氣,未經破壞而排出的含氟及N₂O氣體

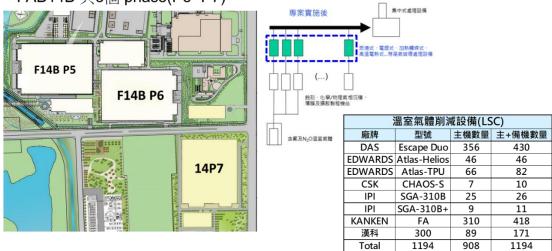
FAB14B 共3個 phase(P5~P7)



專案執行邊界(實施後)

- 範疇為半導體製程中,含有含氟及N₂O溫室氣體使用排放為計畫邊界
 - 專案邊界示意 實施本減量方法共設置908台(主機)尾氣破壞設備(LSC)·排出未經破壞而 排出的含氟及N₂O氣體·及破壞設備使用電力或燃燒而排放的溫室氣體





FAB14B 大門位置之經緯座標: TWD97(東向座標 174878, 北向座標 2556858)

(2)台積電 FAB14B 廠位於台南科學園區三抱竹路沿線土地開發計畫場址,依行政院環保署 108.01.17 環署綜字第 1080005041 號函"台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計畫(第十次變更)"環評影響差異分析報告,位於專 33 與專 34 土地上。從上述環評影響差異分析報告,台南科學園區並未承諾須安裝分解、破壞、回收或替代含氟及 N₂O 溫室氣體或任何含有含氟及 N₂O 溫室氣體的廢氣成分之處理設備,故 FAB14B 並無被強制要求安裝分解、破壞、回收或替代含氟及 N₂O 溫室氣體或任何含有含氟及 N₂O 溫室氣體或任何含有含氟及 N₂O 溫室氣體或任何含有含氟及 N₂O 溫室氣體的廢氣成分之處理設備。

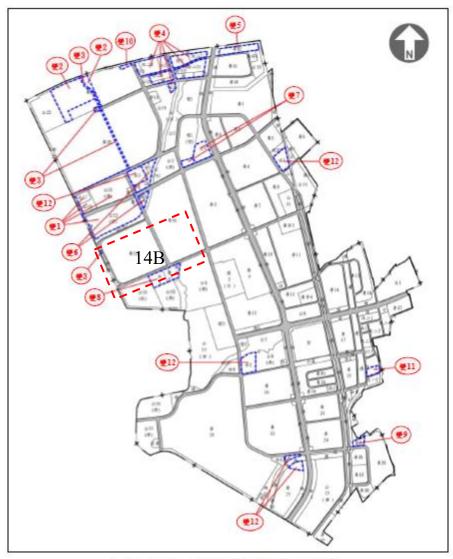


圖 4.3.4-1 本次變更位置示意圖

(3)參考台南科學園區環境影響差異分析書,亦無特別要求含氟氣體及 N₂O 減量。

(3) 交通維持措施

- ·目標年之聯外與區內道路交通量難均達 "D"級以上服務水準,惟仍應健全大眾運輸系統以違降低私人運具使用量之目的,解爭取現有公車路線之服務範圍延伸至台尚園區內、另關新路線行股關區內與柱延鄰經鄉域、以巴士巡迴於園區內各主要道路,提供員工及添公民眾部要。
- 鼓勵園區廠商聯合設置交通車服務系統,減少小客車及機車流量 對聯外道路之交通干擾。

(4) 空氣污染防制

- ·園區內各工廠需依各行業之污染物排放特性,規劃設計空氣污染 防治設備,並確實執行操作。所請放空氣污染物濃度需符合「固 定污染源空氣污染物排放標準」或各行業之掛放標準。
- 園區內各工廠需依「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」等相關規定設置煙道監測系統,以掌握及進一步改善污染締故情況。

-8-8-

- 鼓勵園區廠商採目前可行之最佳控制技術進行污染防治,未來行 政院環境保護署公告各行業之最佳可行控制技術後,園區廠商頻 配合進行控制技術之改善。
- 園區廠商須加強對污染防制設備操作人員之訓練,使其熟悉各種 操作程序;加強生產操作程序控制,減少設備異常或污染防治設 備故障而排放大量污染物之機會。
- 鼓勵園區員工搭乘交通車,以減少聯外道路車輛排放廢氣。
- 配合環保單位定期辦理稽查工作,以使污染防治設備得以確保其功能。
- 於園區內通當地點進行空氣品質檢測,若餐規傾測值超過空氣品 質標準限值,則並完其污染源之出處,並要求排放此類污染量之 工廠接取減量播放,降低其排放量避免使空氣品質惡化。
- 園區廠商進駐80%後二年內,進行有機酸及二次衍生性粒狀污染物繳量之評估檢討。

6.10 溫室氣體

一、本次用 電增量

台南國區為因應後續進駐之先進半等體產業製程用電量增加,以至於接給全區最高用電量網由原本211.5萬托增為299.5萬瓩,增加約88萬瓩。並經台電公司表示可供應台南國區所寫增加用電量88萬瓩(台灣電力股份有限公司106年11月24日電視 字第1068113693號函)。

依據經濟部能源局網站公告之106年度電力排放係數,每度電約產生0.554公斤二 氧化碳,排估台南國區用電增加88萬瓩,產生之溫室氣體排放增量約為427萬公噸 二氧化碳/年,其計算式如下:

88 萬 kW×24hr/天×365 天/年×0.554kg-CO₂/度÷1000kg≒427 萬 tonCO₂/年

二、園區節能減礦現況

南科台南園區多年來致力於節能減碳計畫,相關規劃如園 6.10-1 所示, 執行項目包含:金葉社會責任(CSR)、太陽能素統改置、傳統燈具次換表 LED 燈、電影士試營運計畫、園區極截、園區最前節能輔導,取行鑽石級煉建築生電影社區機章、鑽石級煉建築標準、擴色、無機變、清潔生產證書等。未來本園區將持續落實節能減碳措施,相關節能減碳措施規劃或果提明如下;

(一)永續報告書(CSR)

南科祭獲 2016 台灣企業永續獎(TCSA)「非營利組織組 TOP 50 最高等 級金獎」及「社會共興獎」雙獎青定,廠商 25 家金業餐行企業社會責 任(Corporate Social Responsibility ASR)。 透過園医管理局和廠商以自 發性體認金業社會責任之重要性,特KAK傳 環保 酚氮蒸實於企業經營。

(二) 太陽能光電系統

南科台南園區位於台灣南部日照充足地區,具備發展太陽能光電系統之優勢,107年4月底共已設置約6,226kW太陽能光電發電系統。

初步推估年發電量共計尚為 9,544,458 度電、依據經濟部能源局側站公告 之 106 年度電力排放係數、每度電的產生 0.554 公斤二氧化碳、換算太陽 能光電發電系統發電量之年溫至氣體排放減量的為 5,288 ton CO2。

太陽能光電發電系統發電量之溫室氣體排放減量:

9,544,458 度電×0.554 kg-CO2/度÷1,000kg≒5,288 ton CO2/年

(三) LED 燈具

南科台南園區近年來逐步將園區內高壓納路燈汰換為 LED 路燈,以降 低用電量,截至 106 年 12 月止已將全數汰換完成,共計汰換掉 2,873 蓋高壓納路燈,其中 365 蓋 400W 高壓納路燈汰換為 145W LED 路燈、

- 3.資金來源說明:專案計畫之資金來源均為本公司,並無來自我國政府單位之資金 援助。
- 4.專案活動對永續發展的貢獻:本專案計畫預期可大幅減少溫室氣體排放,減緩全球暖化氣候變遷對環境整體的負面衝擊。

5.預期減量成果:

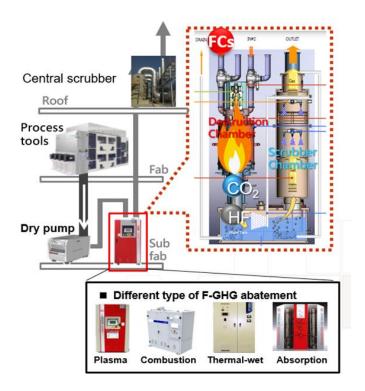
本專案預期減量成果不包含水洗式控管措施,僅計算蝕刻、化學/物理氣相沉積、薄膜、擴散製程安裝含氟及 N2O 溫室氣體尾氣處理設備之減量效益,並以 IPCC 2006 之方法來進行含氟及 N2O 溫室氣體基線排放量及計畫執行減排量估算,預期每年減量 261,630 噸 CO2e,計入期十年共減少 2,616,300 噸 CO2e,安裝含氟及 N2O 溫室氣體尾氣處理設備後之預期減量成果如表一所示,各減量設備之資料明細如表二(共設置 908 台減量設備)。

表一、預期減量成果

單年期間	年排放減量/移除量估計值 (單位:公噸CO2當量)
109/11/2~110/11/1	261,630
110/11/2~111/11/1	261,630
111/11/2~112/11/1	261,630
112/11/2~113/11/1	261,630
113/11/2~114/11/1	261,630
114/11/2~115/11/1	261,630
115/11/2~116/11/1	261,630
116/11/2~117/11/1	261,630
117/11/2~118/11/1	261,630
118/11/2~119/11/1	261,630
總排放減量/移除量估計值	2 646 200
(公頓CO2當量)	2,616,300
計入期總年數	10
計入期年平均排放減量/移除量估計值 (公噸CO2當量)	261,630

(四)專案活動之技術說明:

根據半導體產業排放特性,可知製程之含氟及 N2O 溫室氣體所佔之溫室氣體排放比例相對為高,是故本公司首要之溫室氣體計畫減量目標即為藉由推動製程中之含氟及 N2O 溫室氣體排放量來進行溫室氣體減量。本公司在含氟及 N2O 溫室氣體排放減量工作的推行狀況,與現今國際間主要大廠的進度一致,甚至有超前的績效。為響應政府機關推動之溫室氣體盤查及自願性減量計畫,台積電 FAB14B 廠引進之尾氣處理設備(LSC)因應不同世代產品而有所精進,引進如 Edwards Helios、IPI 310B+...等新型局部尾氣破壞處理設備。



上表所列之尾氣處理設備形式描述如下:

表二、尾氣處理設備形式

廠牌	型號	形式
DAS	ESCAPE DUO	燃燒式
EDWARDs	Atlas-Helios	燃燒式
EDWARDs	Atlas-TPU	燃燒式
Kanken	KT1000FA	電熱式
IPI	SGA 310B	電熱式
IPI	SGA310B+	電熱式
漢科	WTC-300	電熱式
CSK	CHAOS	電漿式

本表填寫計入期(民國 108 年)之資料情境說明

- 1. 民國 108 年後不再新增購入機台
- 2. 每台 LSC 燃料與電力用量均使用額定用(氣/電)量計算(全年 365 天運轉)
- 3. 現況填寫之機台含氟及 N₂O 溫室氣體年使用量數值,考慮各氣體民國 108 年全廠領用量(使用量)與歷史年(民國 105 年 1 月 1 日~107 年 12 月 31 日)平均全廠領用量(使用量) 比較之最小值(各別氣體取低者),再分攤至各機台之分配值

二、減量方法適用性及外加性分析描述:

(一)專案活動採用之減量方法:

本專案採用 TM002 半導體產業含氟及 N_2O 溫室氣體破壞處理設備排放減量方法學,為製程中安裝燃燒式、電熱式、電漿式之含氟及 N_2O 溫室氣體破壞處理設備,以減少含氟及 N_2O 溫室氣體從蝕刻、化學/物理氣相沉積、薄膜及擴散製程中的使用排放。

(二)適用條件與原因:

本減量方法是以半導體產業製程之各種含氟及 N2O 溫室氣體為研究範圍,而本減量方法之起始年不得早於『行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則』99 年,計畫計入期之組織型碳排放量須向國家登錄平台登錄後始得計入減量績效,直到製程除役為止,本方法相關適用性如下:

表三、適用條件與本廠適用列表

項	方法學適用條件	本廠適用條件
目		
1	本方法學只適用於積體電路	台積電 FAB14B 廠為積體電路製造產業。
	(Integrated Circuit,以下簡稱 IC)製造	
	產業。其它對象包括半導體材料(含化	
	學品)、光罩、設計(含電腦輔助設計	
	Computer Aided Design, CAD 軟體)、	
	製程、封裝、測試及設備等,並不適	
	用本方法學	
2	本方法學安裝破壞處理設備無區分全	
	新設備、或二手設備,須考量安裝之	
	設備破壞去除率之有效性(非為裝設	台積電 FAB14B 廠用安裝破壞處理設備皆為全新設
	應用於毒性氣體之低溫電熱式處理設	備,及台積電其他廠移入之設備,並符合 IPCC 與 US
	備),且應參考 IPCC 與 US EPA	EPA Greenhouse Gas Mandatory Reporting Rule,
	Greenhouse Gas Mandatory	須符合含氟溫室氣體之處理設備破壞去除效率大於
	Reporting Rule,須符合含氟溫室氣	90%; N ₂ O 之處理設備破壞去除效率大於 60%。
	體之處理設備破壞去除效率大於	
	90%; N2O 之處理設備破壞去除效率	

	大於60%;由外部公司購買之二手設	
	備於設置完成時應先進行檢測;	
3	本方法學適用於半導體產業之蝕刻、	台積電 FAB14B 廠包含於半導體產業之蝕刻、化學/物
	化學/物理氣相沉積、薄膜及擴散製	理氣相沉積及擴散製程,使用含氟及 N ₂ O 溫室氣體,
	程,在沒有執行減量專案含氟及 N ₂ O	在沒有裝設破壞處理設備前(未執行專案前),含氟及
	溫室氣體乃直接排放到大氣中	N ₂ O 溫室氣體尚未經過處理直接排放,並於專案開始
		時安裝破壞處理設備。
4	製程機台只計算含氟及 N2O 溫室氣	台積電 FAB14B 廠製程機台只計算含氟(CF ₄ 、c-C ₄ F ₈ 、
	體排放減量績效	CHF ₃ 、CH ₂ F ₂ 、CH ₃ F、NF ₃ 和 SF ₆)及 N ₂ O 溫室氣體排
		放減量績效
5	法規未規定須安裝分解、破壞、回收	依行政院環保署 108.01.17 環署綜字第 1080005041 號
	或替代含氟及 N2O 溫室氣體或任何	函"台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計
	含有含氟及 N2O 溫室氣體的廢氣成	畫(第十次變更)"環評影響差異分析報告,台南科學園
	分	區並未承諾須安裝分解、破壞、回收或替代含氟及 N2O
		溫室氣體或任何含有含氟及 N2O 溫室氣體的廢氣成
		分之處理設備,故 FAB14B 並無被強制要求安裝分解、
		破壞、回收或替代含氟及 N2O 溫室氣體或任何含有含
		氟及 N2O 溫室氣體的廢氣成分之處理設備,參照 附
		件七 未裝設尾氣破壞設備(LSC)仍符合排放標準。
6	量產後之既設廠應具有專案年開始前	台積電 FAB14B 廠於民國 102 年建廠,並於民國 103
	連續三年之含氟及 N2O 溫室氣體使	年後開始生產十二吋晶圓,本專案使用量產後之既設
	用量及使用率歷史資料;量產後之新	廠應具有專案年開始前連續三年(民國 105 年 1 月 1 日
	設廠應具有專案年開始前連續二年之	~107 年 12 月 31 日)之含氟及 N2O 溫室氣體使用量及
	含氟及 N2O 溫室氣體使用量及使用	使用率歷史資料
	率歷史資料	

7 破壞處理設備的最大處理能力必須大 於含氟及 N2O 溫室氣體進入破壞處 理設備處理流量(包含所有其他副產 物及稀釋氣體)之歷史數據 台積電 FAB14B 廠確認破壞處理設備的最大處理能力 大於含氟及 N2O 溫室氣體進入破壞處理設備處理流 量(包含所有其他副產物及稀釋氣體)之歷史數據,破 壞處裡設備最大處理流量如下表:

廠牌	型號	MAX Capacity(slm)	實際流量(slm)
DAS	ESCAPE DUO	300	69.2(37~100)
EDWARDS	Atlas TPU	200	53.5 (30~90)
EDWARDS	Atlas Helios	300	54.3(32~92)
CSK	CHAOS	200	99.1(79~139)
IPI	SGA310B	250	33 (13~80)
IPI	SGA310B+	200	33(15~77)
KANKEN	KT1000FA	250	79.5(50~110)
漢科	WTC-300	225	60.21(35~96)

8 專案申請者,應評估尾氣破壞處理設 備使用年限大於專案期限,既有設備 因故障或老舊,而不能繼續使用之情 形,則不適用本方法,另該去除設備 已屬先期專案中之減量措施者,亦不 能再就此方法申請 台積電 FAB14B 廠尾氣破壞處理設備皆於民國 103 年6月5 號後裝設(但部分機台於民國 101 年購置),依廠商提供設備壽齡如下表,推估均大於專案期限(民國 117 年12 月 31 日),詳細日期整理於抵換專案計算表第四版 14B 試算 202007V3.pdf。

	LSC 壽齡	
DAS	ESCAPE DUO	25年
EDWARDS	Atlas-Helios	20年
EDWARDS	Atlas-TPU	20年
CSK	CHOAS-S	20年
IPI	SEA-310B	25年
IPI	SEA-310B+	20年
KANKEN	KT1000FA	30年
漢科	WTC-300	25年

9 含氟及 N2O 溫室氣體使用率須有安裝尾氣破壞處理設備之含氟及 N2O 溫室氣體使用量(公噸 CO2e)和晶圓生產面積(m²),晶圓規格依照財務年報之晶圓『出貨量』定義,包含5吋、6吋、8吋、12吋與 18 吋晶圓等

台積電 FAB14B 廠符合含氟及 N2O 溫室氣體使用率 安裝尾氣破壞處理設備之含氟及 N2O 溫室氣體使用量(公噸 CO2e)和晶圓生產面積(m²) ,晶圓規格依照 wafer out(ACCT)之晶圓『生產量』定義為 12 吋晶圓,與財務年報定義相同。

10 各類溫室氣體以環保署公告之全球暖化潛勢氣體類別為依據

台積電FAB14B廠依據TM002半導體產業含氟及N₂O 溫室氣體破壞處理設備排放減量方法,使用全球暖化 潛勢如下: CF₄(6,500)、C₂F₆(9,200)、C₃F₈(7,000)、c-C₄F₈(8,700)、CHF₃(11,700)、CH₂F₂(650)、 CH₃F(150)、SF₆(23,900)、N₂O(310)和NF₃(16,100)。

(三)專案邊界內包括的排放源和氣體:

本減量方法範疇為半導體產業的製程中,含有含氟及 N2O 溫室氣體使用排放為計畫邊界。含氟及 N2O 溫室氣體經實施本減量方法設置破壞設備後將會被破壞,但破壞設備使用電力或燃燒而排放的溫室氣體,亦在計畫的排放亦應列入計算,相關考慮因子如下表說明:

基線	來源	溫室氣體	是否納	說明/解釋
			入	
	使用在蝕刻、化	CO ₂	否	不適用
	學/物理氣相沉	含氟及	是	是在專案情境中被減量的主要氣
	積、薄膜及擴散	N ₂ O 溫		馬曲 月豆
	製程	室氣體		
專案	未經減量的含氟	CO ₂ 、	是	1.產生自因操作尾氣破壞處理設
活動	及 N ₂ O 溫室氣	CH ₄ 及		備所使用的電力及化石燃料
	體 及 CO2 排放	N ₂ O		2.造成之溫室氣體排放包括
	量			CO2、CH4及N2O
		含氟及	是	部份未經破壞而排出的含氟及
		N ₂ O 溫		N ₂ O 溫室氣體
		室氣體		

表四、基線及專案活動邊界說明

(四)基線情境之選擇與說明:

依減量方法 5.2 及 CDM Tool 02"Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality(Version 07.0)"要求進行替代方案情境鑑別。

有可能的替代方案包含如下:

1. 不申請抵換專案計畫下,執行含氟及 N2O 溫室氣體尾氣處理。

在不申請抵換專案計畫情境下,原自願性減量行為,執行含氟及 N2O 溫室氣體處理。

2. 以未設置尾氣破壞設備時連續使用含氟及 N2O 溫室氣體。

目前相關產業在既有廠內製程仍繼續使用含氟及 N2O 溫室氣體,是否安裝破壞處理設備來進行含氟及 N2O 溫室氣體減量,對生產製程並無影響。實踐(common practice)性而言,產業並未普遍安裝此設備。半導體產業在蝕刻、化學/物理氣相沉積

及擴散尾氣處理設備,只要安裝水洗裝置,即能將製程有害氣體去除。基於安全性的防範措施,並無需要安裝高溫的尾氣處理設施。產業普遍皆以中央水洗設備為主要的尾氣設備。

3. 評估使用含氟及 N₂O 溫室氣體的替代性氣體:包含其它氣體取代及低 GWP 氟碳化合物取代高 GWP 氟碳化合物。

台積電 FAB14B 廠薄膜(CVD)製程 Chamber clean 已是最佳技術: remote plasma (NF₃),不用其它 FC 類氣體;另外蝕刻(ETC)製程因 FC 類氣體使用會有製程特性及選擇性問題,因此無替代性氣體取代情境。

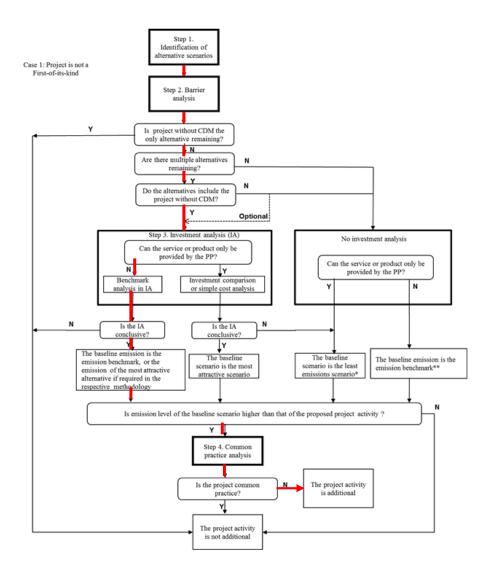
4. 製程最適化調整:製程修改使含氟及 N₂O 溫室氣體消耗量降到最低,將會使排放量降低。

目前半導體產業致力降低材料成本,已將含氟及 N2O 溫室氣體的使用量降到最低,在未安裝尾氣破壞處理設備時無法降低含氟及 N2O 溫室氣體排放量,在經濟可行最佳化和製程良率並且不危害安全範圍內,本公司已將含氟及 N2O 溫室氣體使用量調整至最佳化的使用量,因此不會再發生最適化的調整。

5. 回收技術:目前本產業含氟及 N₂O 溫室氣體回收後再利用技術尚未成熟。

(五) 外加性之分析與說明:

依據 CDM TOOL 02 "Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality(Version 07.0)之 Case1 Project is not a first-of-its-kind",步驟如下:



資料來源:"Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality" (ver.07.0)

Step1 定義情境:依上述可能之替代情境論證本計畫活動可能之基線情境

Step 2 障礙分析:

依據(四)基線情境之選擇與說明中各項替代情境方案進行障礙分析作以下說明:

(1) 不申請抵換專案計畫下,執行含氟及 N₂O 溫室氣體尾氣處理。

在不申請抵換專案計畫下,自願減量進行含氟及 N_2O 溫室氣體尾氣處理,本計畫所裝設的尾氣破壞減量設備,雖不會有額外經濟收入或提高晶圓生產量,但在本公司以削減含氟及 N_2O 溫室氣體尾氣來保護環境的考量下,本替代情境為可行。

(2) 以未設置尾氣破壞設備時連續使用含氟及 N₂O 溫室氣體。

含氟及 N₂O 溫室氣體使用完後直接排放大氣,無技術及投資等障礙,本替代情境為可行。

(3) 評估使用含氟及 N₂O 溫室氣體的替代性氣體:包含其它氣體取代及低 GWP 氟碳化合物取代高 GWP 氟碳化合物。

台積電 14B 廠薄膜(CVD)製程 Chamber clean 已是最佳技術: remote plasma NF3; 蝕刻(ETC)製程因製程特性及選擇性而使用特定 FC 氣體,因此無替代性氣體取代情境。

(4) 製程最適化調整: 製程修改使含氟及 N_2O 溫室氣體消耗量降到最低,將會使排放量降低。

目前半導體產業致力降低材料成本,已將含氟及 N_2O 溫室氣體的使用量降到最低,在未安裝尾氣破壞處理設備時無法降低含氟及 N_2O 溫室氣體排放量,在經濟可行最佳化和製程良率並且不危害安全範圍內,本公司已將含氟及 N_2O 溫室氣體使用量調整至最佳化的使用量,因此不會再發生最適化的調整。

(5) 回收技術:目前本產業含氟及 N₂O 溫室氣體尚未有回收後再利用技術,因此無替代性氣體取代情境。

依據上述說明,在排除(3)~(5)情境後, 仍有二個可行的替代情境(more than one alternative scenario),且在不申請抵換專案計畫下,執行本專案為替代情境之一,故需進入 Step 3 投資分析(Investment Analysis)。

Step 3:投資分析

本專案為本公司廠內執行之專案,只有本公司可執行,可選擇投資比較法 (Investment Comparison Analysis)或簡單成本分析法(Simple cost analysis)。因本專案 以成本支出為主且未有實際收入,故選擇簡單成本分析法(Simple cost analysis)進行。

替代情境(1) 不申請抵換專案計畫下,執行含氟及 N₂O 溫室氣體尾氣處理。減量削減設備需要額外設置經費(詳見附件四),經簡易投資分析(不包含操作維護費用,以 5 年計算 LSC 折舊年限),因沒有實質投資效益(如節省電費等),故投資回收年限無限長。因回收年限,故敏感度分析亦可確認。

替代情境(2) 未安裝破壞處理設備,未有額外支出。

由上述情境之投資分析下,替代情境(2)較替代情境(1)具財務吸引力,故以替代情境(2)為基線情境;進入 Step 4 實踐分析(Common practice analysis)。

Step 4: 實踐分析(Common practice analysis)

以國內同製程/主要產品廠設立局部破壞去除設備設置情況,引用CDM實踐性分析工

具(TOOL24 Methodological tool common practice, version 03.1)進行<u>實踐</u>性分析。

步驟 1: 以專案基準年(民國 $105\sim107$ 年)數據計算,申請抵換廠區 F14P56 廠(12 吋代工製程、主要產品製程 20/16 nm) 基準年之平均晶圓面積為 $70,126\text{m}^2$,以+/-50% range 計算分別為 $35,063\sim105,189\text{m}^2$ 。申請抵換廠區 F14P7 廠(12 吋代工製程、主要產品製程 20/16 nm) 基準年之晶圓面積為 $308,85\text{m}^2$,以+/-50% range 計算分別為 $15,442\sim46,327\text{m}^2$ 。

步驟 2:依據台灣半導體產業協會(TSIA)提供的資料中,國內民國 105~107 年 12 吋代工製程廠設立局部破壞去除設備設置情況,除本專案申請抵換廠區外共計 13 個廠別。符合 F14P56/F14P7 廠步驟 1 產能 range 且基準年主要產品製程 20/16nm 並設置有局部破壞去除設備,除本專案申請抵換廠區外共計 0 個廠別。

步驟 3: 符合申請抵換廠區 F14P56 廠步驟 1 產能 range、主要產品製程 20/16nm、設置有局部破壞去除設備,且未申請 CDM 之廠區,除本專案申請抵換廠區外共計 0 個廠別,故此 $N_{all,\;F14P56}=0$;符合申請抵換廠區 F14P7 廠步驟 1 產能 range、主要產品製程 20/16nm、設置有局部破壞去除設備,且未申請 CDM 之廠區,除本專案申請抵換廠區外共計 0 個廠別,故此 $N_{all,\;F14P7}=0$ 。

步驟 4: $N_{all,F14P56}$ 中所使用的技術與本專案皆使用有效尾氣破壞處理設備,故此 $N_{diff,F14P56}=0$; $N_{all,F14P7}$ 中所使用的技術與本專案皆使用有效尾氣破壞處理設備,故此 $N_{diff,F14P7}=0$ 。

步驟 5: 在 Factor,F = 1- N_{diff}/N_{all} > 0.2 且 N_{all} - N_{diff} > 3 情况下為 common practice。經計算, $F_{F14P56}=1$ - $N_{diff,F14P56}/N_{all,F14P56}=1$ -(0/0) = 1 > 0.2 但 $N_{all,F14P56}$ - $N_{diff,F14P56}=0$ -0 = 0 < 3 以及 $F_{F14P7}=1$ - $N_{diff,F14P7}/N_{all,F14P7}=1$ -(0/0) = 1 > 0.2 但 $N_{all,F14P7}$ - $N_{diff,F14P7}=0$ -0 = 0 < 3 情形下,此專案並非 common practice

三、減量/移除量計算說明:

(一) 減量/移除量計算描述:

1. 基線排放量計算

將蝕刻、化學/物理氣相沉積、薄膜及擴散機台未安裝破壞之含氟及 N_2O 溫室氣體 年使用量,乘上剩餘之製程氣體利用率(1-Ui),再乘上 IPCC 第二次評估報告 GWP 值,相關計算公式說明如下:

 $(\not\precsim 1) \qquad \mathsf{E}_{\,\mathsf{FCN_2O}\,\,i_{j_1}} = (\mathsf{C}_{\,\mathsf{FCN_2O}\,\,i_{j_1}})\,[\,(1-\mathsf{Ui})\,(\mathsf{GWP}_{\mathsf{FCN_2O}\,\,i_{j}}) + (\mathsf{B}_{i_1},\,_{\mathsf{CF}_4})(\mathsf{GWP}_{\mathsf{CF}_4}) + (\mathsf{B}_{i_1},\,_{\mathsf{C}_2\mathsf{F}_6})\,(\mathsf{GWP}_{\mathsf{C}_2\mathsf{F}_6})\,]$

參數	定義	單位
i	表示各含氟及 N ₂ O 氣體	-
E _{FC/N₂Oi,}	未安裝 LS 時含氟及 N ₂ O 溫室氣體排放量	tCO ₂ e
C _{FC/N₂Oi,}	本廠使用 FDC 系統抓取機台使用之 recipe,計算各機台所使用含氟及 N ₂ O 使用量,再以整廠區總量經殘氣率換算後,進行各機台分配,做為個別含氟及 N ₂ O 溫室氣體年使用量(公噸)之計算,既設廠將取專案起始年之前連續三年加權平均值。	Ton
Ui	製程氣體利用率為 2006 IPCC Guideline default 值及 2013 US EPA GHG Reporting Rule default 值	%
Bi, cf₄	CF ₄ 氣體生成率,使用 2006 IPCC guideline default 值	-
Bi, c₂F₅	C ₂ F ₆ 氣體生成率,使用 2006 IPCC guideline default 值	-
GWP _{CF₄}	CF4溫室氣體潛勢,採用 IPCC 第二次評估報告之 GWP 值(6500)。	Kg CO ₂ e/kgCF ₄
GWP _{C₂Fe}	C ₂ F ₆ 溫室氣體潛勢,採用 IPCC 第二次評估報告之 GWP 值(9200)。	Kg CO2e/kgC ₂ F ₆
GWP _{FC/N₂0i,}	使用 IPCC 第二次評估報告公告之溫室氣體潛勢來計算含氟及 N_2O 溫室氣體轉換為 CO_2 當量值 (註:由於 IPCC 第二次評估報告無 NF_3 之 GWP 值。故 NF_3 採 IPCC 第五次評估報告之 GWP 值。)	Kg CO ₂ e/kg 氣體

本減量專案所安裝含氟及 N_2O 溫室氣體破壞處理設備,在相同製程氣體條件下,將取製程設備含氟及 N_2O 溫室氣體年使用當量(公噸 CO_2e),除以製程設備生產出之晶圓面積(m^2)為本專案之含氟及 N_2O 溫室氣體使用率,歷史年含氟及 N_2O 溫室氣體 當量使用率為專案起始年之前連續三年加權平均值。

(式 2)
$$\mathsf{E}_{\mathsf{FCN}_2\mathsf{O}_{\mathsf{i},\mathsf{Y}}} = \min \left(\mathsf{E}_{\mathsf{FCN}_2\mathsf{O}_{\mathsf{i},\mathsf{h}}} , \mathsf{E}_{\mathsf{FCN}_2\mathsf{O}_{\mathsf{i},\mathsf{Y}}} \right)$$

$$(\vec{\sharp} 3) \qquad F = \frac{\sum C_{FC/N_2O_{\dot{\downarrow}}} * GWP_{FC/N_2O_{\dot{\downarrow}}}}{\sum P}$$

參數	定義	單位
у	專案年	-
h	歷史年	-
E _{FC/N₂Oi,y}	專案年未安裝 LS 時含氟及 N ₂ O 溫室氣體排放量	tCO ₂ e
E _{FC/N₂Oi,h}	歷史年未安裝 LS 時含氟及 N ₂ O 溫室氣體排放量	tCO ₂ e
F	總含氟及 N ₂ O 溫室氣體當量使用率=總含氟及 N ₂ O	tCO ₂ e/m ²
	溫室氣體年使用當量(公噸 CO ₂ e)/設備晶圓年生產	
	面積(m ²);既設廠總含氟及 N ₂ O 溫室氣體當量使用	
	率(Fh)將取專案起始年之前連續三年加權平均值。	
C _{FC/N₂O i}	個別含氟及 N ₂ O 溫室氣體年用量	Ton
P	晶圓年生產面積	m^2

本專案含氟及 N_2O 溫室氣體使用因子(k)為歷史年含氟及 N_2O 溫室氣體使用率除以專案年含氟及 N_2O 溫室氣體使用率,若專案年含氟及 N_2O 溫室氣體使用率低於歷史年含氟及 N_2O 溫室氣體使用率時,以歷史年含氟及 N_2O 溫室氣體使用率為上限,即 k 值以 1 計算。反之則以專案含氟及 N_2O 溫室氣體使用因子(k)進行計算。

(式 4) BEy = k
$$\sum E_{FC/N-Oily}$$

(式 5)
$$\mathbf{k}=Fh/Fy$$
 且 $k=min(1,Fh/Fy)$

$$(\vec{x}, 6) \qquad \qquad \underline{E_h} = \frac{\sum C_{\text{FC/N}_2O_{\hat{i},h}} * \text{GWP}_{\text{FC/N}_2O_{\hat{i}}}}{\sum E_h}$$

(式7)
$$\frac{\sum C_{\text{FCN-20 i,y}} *GWP_{\text{FCN-20 i}}}{\sum Py}$$

參數	定義	單位
ВЕу	專案年基線排放當量(公噸 CO ₂ e),本減量方法可能包含 多種型式之蝕刻、化學/物理氣相沉積、薄膜及擴散機台	tCO ₂ e
k	總含氟及 N_2O 溫室氣體使用因子=歷史年總含氟及 N_2O 溫室氣體當量使用率/專案年總含氟及 N_2O 溫室氣體當量使用率;若 $k \ge 1$,則以 1 計算;若 $k < 1$,則以 k 值計算	
Fh	歷史年總含氟及 N ₂ O 溫室氣體當量使用率	tCO ₂ e/m ²
Fy	專案年總含氟及 N ₂ O 溫室氣體當量使用率	tCO ₂ e/m ²
C FC/N ₂ O į,h	歷史年個別含氟及 N_2O 溫室氣體年使用量,既設廠將取專案起始年之前連續三年加權平均值。	Ton
С _{FC/N2} O _{j, у}	專案年個別含氟及 N ₂ O 溫室氣體年使用量	Ton
Ph	歷史年設備晶圓年生產面積 m	
Py	專案年設備晶圓年生產面積	m^2

2.專案排放量計算

基線排放量乘上破壞設備的剩餘破壞去除率(1-DRE),加上減量設備操作期間電力和天然氣的使用額外所造成的 CO₂ 排放當量,即為專案排放量計算,公式如下:

(式 8)
$$PE_y = BE_y \times T_{Rate} \times (1-DRE_{FC/N_2Oi, y}) + BE_y \times (1-T_{Rate}) + C_{CO_2y}$$

$$C_{CO_2 y} = (TE_y x EF_{ELEC,y}) + TF_y x EF_{FUEL,y})$$
(\(\pm 9\)

採用原則是必須確認 FCs 破壞去除效率檢測值高於 2006 IPCC Guideline default 值(90%); N_2O 破壞去除效率檢測值高於 2013 US EPA GHG Reporting Rule default 值(60%)。以專案執行開始後該處理設備之含氟及 N_2O 溫室氣體 inlet 與 outlet 檢測值計算 (減量績效氣體之同型設備,擇一檢測),處理設備之 DRE 須每三年檢測一次。

若處理設備破壞去除率高於 IPCC Guideline / US EPA GHG Reporting Rule default 去除率時,DREy 取 IPCC / US EPA GHG Reporting Rule 之預設值;反之專案年處理設備破壞去除率低於 IPCC Guideline / US EPA GHG Reporting Rule default 去除率時,DREy 為實際檢測值。

参數	定義	單位
PE _y	專案年排放量(公噸 CO ₂ e),本減量方法可能包含多種型式之破壞處理設備(LS)	tCO ₂ e
BE_y	專案年基線排放量	tCO ₂ e
DRE _{FC/N₂} Oi,y	處理設備之破壞去除效率(FCs 採用 2006 IPCC Guideline default 值,90%; N ₂ O 採用 2013 US EPA GHG Reporting Rule default 值,60%)。	%
C co ₂ y	為使用電力及燃料造成之 CO ₂ 排放量	tCO ₂ e
TE _y	專案年之電力使用量	MWh
TF _y	專案年之破壞設備燃料使用量	1000 Nm ³ /year
EF_ELEC,y	專案年國內電力排放係數參照值	(Kg CO ₂ e/kwh)
EF_ _{FUEL,y}	燃料之排放係數參照值	(Kg
ED	(依2006年版IPCC Data或國家參考值) 專案年破壞處理設備達有效處理參數之總日數	CO ₂ e/Nm³)
N	破壞處理設備數量	台
PD	專案年破壞處理設備維護保養或停機總日數	日

4. 專案排放減量計算

本專案的排放減量是以有效的尾氣破壞處理設備操作期間為限,其排放減量公式如下所列:

(-)單一氣體供應源,提供給單一製程及單一尾氣破壞處理設備型式時,其排放減量 $(式 \ 10) \hspace{1.5cm} \mathsf{ER}_{\, V} = \left(\mathsf{BE}_{\, V} - \mathsf{PE}_{\, V}\right)$

(二)非上述(一)製程情形其排放減量,為遵守保守性原則,排放減量乘修正係數 R。

(式 11)
$$ER_{y} = (BE_{y} \times R - PE_{y})$$

參數	定義	單位
ERy	第 y 年減量	tCO ₂ e
BEy	第y年基線排放量	tCO ₂ e
PEy	第y年專案排放量	tCO ₂ e
R	修正係數(R<1)	-

修正係數 R:

考量各項含氟及 N₂O 溫室氣體生產製程參數(包含時間、質流量等參數)計算機 台總使用量,與氣瓶總供應量之機台分配加總不確定性,依修正係數 R 進行基線排 放量修正,未包含於該表中氣體者取保守值 82%進行修正。

表五、計算排放減量之修正係數 R

7 Z - 0 J - 17 X -
修正係數 R
82%
93%
94%
82%
92%
82%
82%
98%
94%
82%

資料來源:Ju-Hsiu Cheng, Study the uncertainty of FCs process utilization rates (Tier 2b) in the semiconductor industry, IHTESH, 2012

4.所引用之預設係數與參數說明

表六、未監測的數據與參數

數據/參數	GWPi
數據單位	Kg CO ₂ e/kg
描述	含氟及 N ₂ O 溫室氣體全球暖化潛勢
數據來源	含氟温室氣體採 IPCC 第二次評估報告(1995) ;NF3採 IPCC
数 據 不 <i>你</i>	第五次評估報告(2013)
	$CF_4(6,500) \cdot C_2F_6(9,200) \cdot C_3F_8(7,000) \cdot c-C_4F_8(8,700) \cdot$
應用的數值	$CHF_3(11,700) \cdot CH_2F_2(650) \cdot CH_3F(150) \cdot SF_6(23,900) \cdot$
	N ₂ O(310)和 NF ₃ (16,100)。
數據選擇或	引用方法學規範之 IPCC 評估報告數據
量測方法和程序	引用力法字规軋之IFOO 計估報古數據
數據用途	計算基線排放;計算專案排放
備註	

數據/參數	Ui
數據單位	無單位
	製程氣體機台利用率
描述	為2006 IPCC Guideline(ETC CF4、CHF3、CH2F2、NF3、C4F8、
和亚	CH ₃ F、SF ₆ ; CVD N ₂ O、NF ₃ 及 NF ₃ REMOTE)及2013 US EPA
	GHG Reporting Rule default 值
數據來源	2006 IPCC Guideline 電子業;
製 像 不 源	US EPA GHG Reporting Rule
應用的數值	ETC CF ₄ : 0.3 \ CHF ₃ : 0.6 \ CH ₂ F ₂ : 0.94 \ NF ₃ : 0.8 \ C ₄ F ₈ : 0.8 \
應用的製 值	CH ₃ F:0.67、SF ₆ :0.8; CVD N ₂ O:0.3、NF ₃ :0.8及 NF ₃ REMOTE:0.98
數據選擇或	依製程及氣體類別
量測方法和程序	代表在 及制題類別
數據用途	計算基線排放;計算專案排放
	(1) 依 IPCC Guideline / US EPA GHG Reporting Rule 公告
備註	更新
	(2) NF3使用於蝕刻時,採用化學氣相沉積參數

數據/參數	DRE FC/N ₂ O
數據單位	%
描述	含氟及 N ₂ O 溫室氣體破壞處理設備之破壞效率
數據來源	2006 IPCC Guideline 電子業;
数像不 你	US EPA GHG Reporting Rule
應用的數值	含氟氣體 DRE=90%及 N ₂ O DRE=60%
數據選擇或	依破壞處理設備及氣體類別
量測方法和程序	
數據用途	計算專案排放
備註	依 IPCC Guideline / US EPA GHG Reporting Rule 公告更新

數據/參數	Bi, cf₄	Bi, cf.				
數據單位	無單位					
描述	CF4氣體生	上成率				
數據來源	2006 IPC	C Guideline	電子業			
應用的數值	製程	FCs氣體	副產物 CF ₄ 生成 B _{i,CF4}			
	ETC	CF4 C4F8 CHF3 CH2F2 CH3F NF3 SF6	0.2 0.07 0.08 0.045 0.1			
	CVD	N2O NF3 REMOTE NF3	0.02			
數據選擇或 量測方法和程序	依破壞處	依破壞處理設備及氣體類別				
數據用途	計算基線.	計算基線排放;計算專案排放				
備註						

數據/參數	Bi, c₂F₅	Bi, C₂F₅			
數據單位	無單位				
描述	C ₂ F ₆ 氣骨	豊生成率			
數據來源	2006 IP	CC Guideli	ine 電-		
	製程	FCs氣體	副產物 C ₂ F ₆ 生成 B _{i,C2F6}		
		CF4 C4F8	0.2		
應用的數值	ETC	CHF3 CH2F2			
		CH3F NF3 SF6	0.00087		
	CVD	N2O NF3 REMOTE NF3			
數據選擇或	公 动 l	2四小儿刀	卢 眦 坎		
量測方法和程序	化破 環质	依破壞處理設備及氣體類別			

數據用途	計算基線排放;計算專案排放
備註	

數據/參數	C FC/N₂O į,h
數據單位	公頓
描述	歷史年含氟及 N2O 溫室氣體年度使用量
數據來源	領用紀錄
應用的數值	如附件三
數據選擇或 量測方法和程序	各氣體之用量統計報表
數據用途	計算基線排放
備註	

數據/參數	TFy	TFy			
數據單位	1000 Nm ³				
描述	破壞設備之物	然料使用的	量		
數據來源	設備設計值				
	LSC 額定耗電量		NG(slm)		
座田仏制 な	DAS	Escape Duo	25		
應用的數值	EDWARDS	Atlas-Helios	29		
	EDWARDS	Atlas-TPU	46		
數據選擇或	加德凯供锅	左	> 歴 羽		
量測方法和程序	破壞設備操作所使用之燃料				
數據用途	計算專案排放				
備註					

數據/參數	TEy					
數據單位	MWh					
描述	破壞設備之電力使用量					
數據來源	設備設計值					
	LSC 額定耗電量 M Wh/y					
	DAS Escape Duo 6.57					
	EDWARDS Atlas-Helios 70.08					
	EDWARDS Atlas-TPU 35.04					
應用的數值	CSK CHAOS-S 113.88					
	IPI SGA-310B 192.72					
	IPI SGA-310B+ 157.68					
	KANKEN-KT1000FA FA 52.56					
	漢科WTC-300 300 131.4					
數據選擇或	· 中 · 一 · / · / · · · · · · · · · · · · · ·					
量測方法和程序	破壞設備操作時間					
數據用途	計算專案排放					
	1. 根據處理設備設計之瓦數(kW)乘上操作時間					
備註	2. 破壞設備操作所使用之電力=操作時間*設備設計功率					
加工	3. 基於保守性原則,操作時間採全年計	·算,而未扣除歲修保養				
	的時間,新裝設的減量設備從安裝後開	始計算操作時間				

數據/參數	Ph
數據單位	m^2
描述	歷史年晶圓生產面積
數據來源	TSM system Wafer out 生產紀錄
應用的數值	詳見附件三
數據選擇或	製造部統計報表
量測方法和程序	表边印統司報化
數據用途	計算基線排放
備註	

數據/參數	T _{Rate}
數據單位	-
描述	專案年破壞處理設備達有效處理參數之日數比
相处	$T_{Rate} = ED / (365xN - PD)$
數據來源	點檢及維護保養紀錄
應用的數值	1
數據選擇或	廠務部 LSC 實際運轉記錄
量測方法和程序	做物的 LOO 具际建特 化鳅
數據用途	計算專案排放
備註	

數據/參數	N
數據單位	台
描述	破壞處理設備數量
數據來源	點檢紀錄或設備清冊
應用的數值	908
數據選擇或	
量測方法和程序	做伤的 LOO 具际连特月平
數據用途	計算專案排放
備註	

(二) 減量/移除量計算:

依照上節所述公式,本專案之減量計算如下:

表七、基線年排放量計算

Fab名稱	製程	FCs氣體	FC/N2O氣體進入 機台之總使用量 (kg)	FC/N ₂ O氣體進入 機台之未使用比例 (1-Ui)	FCs使用因子(k值)	FC/N ₂ O GWP AR2(基線年)	副產物 CF ₄ 生成	GWP CH₄	副產物C ₂ F ₆ 生成	GWP C₂F ₆	Total CO ₂ e排放 (kg CO ₂ e)
			(1.9)	(1-01)		(kg CO₂e/kg)	B _{i,CF4}	kg CO₂e/kg	B _{i,C2F6}	kg CO₂e/kg	
		CF4	34,783.93	0.7	1	6500		6500		9200	158,266,868
		C4F8	8,884.33	0.2	1	8700	0.2	6500	0.2	9200	43,355,525
		CHF3	5,606.77	0.4	1	150	0.07	6500		9200	2,887,488
F14B廠計畫年基	ETC	CH2F2	1,460.42	0.06	1	650	0.08	6500		9200	816,377
## 線排放量		CH3F	1,616.74	0.33	1	11700	0.045	6500	0.00087	9200	6,728,076
(105~107年排放		NF3	15,365.30	0.2	1	16100	0.1	6500		9200	59,463,721
量)		SF6	3,012.52	0.2	1	23900		6500		9200	14,399,856
<u> </u>		N2O	261,534.92	0.7	1	310		6500		9200	56,753,079
	CVD	NF3 remote	163,386.84	0.02	1	16100	0.02	6500		9200	73,850,852
		NF3	1,071.46	0.2	1		0.1	6500		9200	696,450
											417,218,291

本表填寫之情境說明:

- 1. 計畫年(民國 108 年)於製程共使用7種含氟溫室氣體及 N₂O 氣體,使用量均大於(民國 105 年~107 年)歷史年加權平均值,故採用歷史年加權平均值
- 2.全部含氟氣體及 N2O 皆有不同之尾氣破壞處理設備,此處填寫分配後之使用量

表八、電力和天然氣造成額外 CO2 排放當量計算

廠牌	型號	能源項目	每台LS能源使用量 電力(MWh) 天然氣(1000 Nm3)	係數	係數單位 ▼	GWP	台數	總CO2e (tonnes)				
		電力	6.57	0.533	kg CO2e/kWh	1		1,246.64				
DAS	ESCAPE DUO			2.0930	kg CO2/Nm3	1	356	10,684.85				
DAS	ESCAPE DUO	天然氣	14.34	0.0000373	kg CH4/Nm3	21	330	4.00				
				0.00000373	kg N2O/Nm3	310		5.90				
		電力	70.08	0.533	kg CO2e/kWh	1		1,718.22				
EDWARDS	Atlas-Helios	天然氣	氣 33.28	2.0930	kg CO2/Nm3	1	46	3,204.13				
EDWARDS	Alias-Helios			0.0000373	kg CH4/Nm3	21		1.20				
									0.00000373	kg N2O/Nm3	310	
		電力	35.04	0.533	kg CO2e/kWh	1		1,232.64				
EDWARDS	Atlan TDII	Atlas-TPU 天然氣 26.39		2.0930	kg CO2/Nm3	1	66	3,645.46				
EDWARDS	Allas-IPU		26.39	0.0000373	kg CH4/Nm3	21		1.36				
				0.00000373	kg N2O/Nm3	310		2.01				
CSK	CHOAS-S	電力	113.88	0.533	kg CO2e/kWh	1	7	424.89				
IPI	SGA-310B	電力	192.72	0.533	kg CO2e/kWh	1	25	2,567.99				
IPI	SGA-310B+	電力	157.68	0.533	kg CO2e/kWh	1	9	756.39				
KANKEN	KT1000FA	電力	52.56	0.533	kg CO2e/kWh	1	310	8,684.49				
漢科	WTC-300	電力	131.4	0.533	kg CO2e/kWh	1	89	6,233.22				
						總量	908	40,415.18				

註:1.GWP使用IPCC第二次評估報告公告之溫室氣體潛勢。

2. 電力及燃料之排放係數使用國家參考值。

表九、專案排放量計算

廠名	FCs/N2O氣體	2016 FCs 排放 BEy	未被破壞FCs排放比 率 (1-DRE)	使用電力及燃料之總排 放	專案總CO2e排放 PEy	專案總CO2e排放 PEy (加上LSC使用電力及燃料之總排放)
	CF4	158,266.87	0.1		15,826.69	
	C2F6	-	0.1		1	
	C3F8	-	0.1		ı	
F14B廠計畫年基	C4F8	43,355.53	0.1		4,335.55	
線排放量(105年	CHF3	2,887.49	0.1	40.415.18	288.75	
排放量)	CH2F2	816.38	0.1	40,413.16	81.64	99,162.93
J/II/A=/	CH3F	6,728.08	0.1		672.81	
	NF3	134,011	0.1		13,401.10	
	SF6	14,399.86	0.1		1,439.99	
	N2O	56,753.08	0.4		22,701.23	
	合計	417,218		40,415.2	58,748	

本表填寫之情境說明:

- 1. 專案年破壞處理設備達有效處理參數之日數比 TRate = ED / (365xN -PD) = 1
- 2. DRE FCN₂Oi,y = 處理設備之破壞去除效率(採用 2006 IPCC Guideline default 值,90%; N₂O 之處理設備破壞去除效率採用 2013 US EPA GHG Reporting Rule 定 義 60%)。

減量/移除量計算

 $ER_y = (BE_y xR) - PE_y$

表十、專案排放減量計算

氣體	基線排放量	專案活動排放量	修正後基線排放量	原始排放減量	修正後排放減量
米ル原	BEy	PEy	(BEy xR)	BEy-PEy	ERy= (BEy xR)- PEy
CF4	158,267	15,827	129,779	142,440	113,952
C2F6	-	-	-	-	-
C3F8	-	-	-	-	-
C4F8	43,356	4,336	35,552	39,020	31,216
CHF3	2,887	289	2,656	2,599	2,368
CH2F2	816	82	669	735	588
CH3F	6,728	673	5,517	6,055	4,844
NF3	134,011	13,401	125,970	120,610	112,569
SF6	14,400	1,440	14,112	12,960	12,672
N2O	56,753	22,701	46,538	34,052	23,836
加上LSC使用電					
力及燃料之總排		40,415		- 40,415	- 40,415
放					
合計	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630

- 1.本廠含氟及 N_2O 氣體則因有不同之尾氣破壞處理設備,排放量與分配相關,故此處排放減量以修正係數 R 計算修正
- 2. 本專案並沒有任何的洩漏部分。

(三)計入期計算摘要(計入期將依註冊通過日期進行調整):

表十一、民國 109 年~119 年 10 年計入期減量預估量

單年期間	基線排放量 BEy	專案活動排放量 PEy	修正後基線排放 量 (BEy xR)	原始排放減量 BEy-PEy	修正後排放減量 ERy= (BEy xR)- PEy
109/11/1~110/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
110/11/1~111/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
111/11/1~112/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
112/11/1~113/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
113/11/1~114/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
114/11/1~115/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
115/11/1~116/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
116/11/1~117/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
117/11/1~118/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
118/11/1~119/11/2	417,218	99,163	360,793	318,055	261,630
總量(公噸CO ₂ e)	4,172,180	991,630	3,607,930	3,180,550	2,616,300

四、監測計畫:

(一)應被監測之數據與參數:

表十二、應被監測之數據與參數

數據/參數	尾 氣破壞處耳	里設備工作溫度	、功率	 、燃料流量				
數據單位	°C · kw · slm							
描述	破壞處理設備之參數,需能達到如設備廠商提出可達 FCs 之處理設備破壞去除效率大於90%; N2O 之處理設備破壞去除效率大於60%以上							
數據來源	設備操作資訊控制介面							
應用的數值	DAS ESCAPE DUO 燃氣比(NG:O ₂)=1:2(NG≥13)、EDWARDS Atlas:燃氣比(NG:O ₂)=25+6.5x:10x,0 <x<4(無 pfcs="" 時,無氧氣供應,鼓風機須開啟以提供氧氣),ng="">20L,O₂有開啟時>5L、EDWARDS Helios:燃料量 NG>20L,鼓風機須開啟以提供氧氣、</x<4(無>							
	CSK CHOAS DC<25A, AC<40A、IPI SGA 310B 400~1050℃、IPI SGA 310B+ 400~1050℃、KANKEN KT1000FA 450~1050℃、溪科 WTC-300 450~1050℃。							
量測方法和程序	依連續監控系統取得包含主備機之破壞削減設備數據							
監測頻率	毎日							
QA/QC 程序	-							
數據用途	確認所有製程機台對應之破壞削減設備在運轉時可達破壞削減率							
	1. 當設備異常時,LSC 會傳送異常的 alarm 指令給廠務中控							
	室,由當班工程師處理,並視情況啟用備機,備機啟用時需符合							
	上述操作參數。							
	2. 破壞處理設備所記載之操作條件容許誤差<10%為有效操作參數。							
	3. CSK CHOAS 為電漿式,以電流值確認處理效率(電壓為 208V)							
		備監控方式及量						
備註	 版牌 DAS	型號 ESCAPE DUO	形式	監控方式/量測點				
	EDWARDS	Atlas	燃燒式	監控一定比例供給的 NG:O2 的				
	EDWARDS	Helios	バベクモン	流量與壓力				
	CSK	CHOAS	電漿式	監控供應電流 DC>12A				
	IPI	SGA310B						
	IPI	SGA310B+	あれい	監控溫度點皆在 heater 加熱的				
	KANKEN	KT1000FA	電熱式	反應腔體				
	I O WINCE IN			<u> </u>				

數據/參數	C _{FC/N₂O j,} y
數據單位	公斤
描述	專案 y 年含氟及 N2O 溫室氣體年度使用量
數據來源	領用紀錄
應用的數值	詳見附件三
量測方法和程序	每月之統計報表
監測頻率	每月
QA/QC 程序	1. 氣瓶櫃半年保養,標準磅秤年校正
QA/QU 在力·	2. 地磅年校正
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	

數據/參數	Ру
數據單位	m^2
描述	專案У年晶圓生產面積
數據來源	TSM system Wafer out(ACCT)
應用的數值	詳見附件三
量測方法和程序	每月之生產紀錄
監測頻率	每月
QA/QC 程序	
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	_

數據/參數	EF_ELEC,y
數據單位	kgCO ₂ e/Kwh
描述	電力之排放係數
數據來源	能源局
應用的數值	107年電力係數: 0.533 kg CO2e/kWh
量測方法和程序	依權責主管機關最新公告
監測頻率	每年
QA/QC 程序	_
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	-

數據/參數	EF_FUEL,y				
數據單位	kgCO₂e/Nm³				
描述	燃料之排放係數				
數據來源	供應商提供之熱值計算				
應用的數值	天然氣: 依天然氣供應商提供熱值計算 2.0930 kg C02/Nm3				

	0.0000373	kg CH4/Nm3
	0.00000373	kg N2O/Nm3
量測方法和程序	定期確認環	保署網站公
監測頻率	每年	
QA/QC 程序	_	
數據用途	計算專案年	温室氣體排
備註	_	

數據/參數	DRE _{monitor,y}
數據單位	%
描述	實際量測之破壞去除效率
數據來源	實際量測
應用的數值	
量測方法和程序	FTIR,見含氟及 N ₂ O 溫室氣體質流量
	依減量設備之型式(電熱式、燃燒式、電漿式)進行群組分類,以
監測頻率	裝設年份最早之同型式減量設備(篩選一台)進行三年一次的檢
	測
QA/QC 程序	-
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	由量測單位提供

數據/參數	含氟及 N ₂ O 溫室氣體質流量
數據單位	kg
描述	處理前後之氣體濃度及體積流量
數據來源	進出口 FTIR 系統
應用的數值	NA(依實際量測值)
	依據下列標準執行:
	1. 空氣中氣相化合物檢測方法—抽氣式霍氏紅外光光譜分析
量測方法和程序	法(NIEA A001)
王州水田十二八	2. Protocol for Measuring Destruction or Removal Efficiency
	(DRE) of Fluorinated Greenhouse Gas Abatement Equipment
	in Electronics Manufacturing. US-EPA. 2010
監測頻率	三年一次
QA/QC 程序	見 FTIR 量測系統所附屬之流量計維護頻率
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	由量測單位提供

數據/參數	FTIR 量測系統所附屬之流量計維護頻率
數據單位	每年維護需求和時間的清單
描述	流量計的維修清單
數據來源	参考設備操作手冊

應用的數值	NA
量測方法和程序	依據製造商手冊進行維護,以流量間接校正法進行校正
監測頻率	三年一次
QA/QC 程序	_
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	由量測單位提供

數據/參數	分子量及其	分子量及其吸收光譜							
數據單位	g/mole								
描述	含氟及 N2	〇溫室	氣體種類	į					
數據來源	分子量								
座 田 幼 軟 <i>体</i>		CF4	C4F8	CHF3	CH2F2	CH3F	NF3	SF6	N2O
應用的數值	分子量	88	200.03	70.01	52.02	34.03	71	146.06	44.013
量測方法和程序	FTIR 光譜	資料庫							
監測頻率	三年一次								
QA/QC 程序	_								
數據用途	計算專案分	丰温室氣	體排放	量					
備註	由量測單位	立提供							

數據/參數	ED
數據單位	日
描述	專案年破壞處理設備達有效處理參數之總日數
數據來源	破壞處理設備達有效處理參數之紀錄系統
應用的數值	365天(依實際運轉為主)
量測方法和程序	廠務破壞處理設備參數狀況每日紀錄
監測頻率	每日
QA/QC 程序	廠務負責工程師檢視到參數出現雜訊時執行檢查,必要時更換
Q/VQO 在介	新品
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	

數據/參數	PD
數據單位	日
描述	專案年破壞處理設備維護保養或停機總日數
數據來源	廠務設備保養紀錄系統
應用的數值	0天(依實際運轉為主)
量測方法和程序	廠務設備維護保養工單系統每日紀錄(計畫性&非計畫性)
監測頻率	每日
QA/QC 程序	維護保養工單內容由現場人員執行項目,並由該工項負責工程
QA/QU 在厅	師確認執行項目完成及簽核。
數據用途	計算專案年溫室氣體排放量
備註	

(二) 抽樣計畫:

本計畫已規劃於計畫計入期第一年(民國 108 年)完成大宗處理設備(Edwards、DAS、CSK、KANKEN、IPI) 之破壞去除效率檢測工作,以確認本廠安裝之此廠牌處理設備均可有效的處理含氟及 N_2O 溫室氣體。。後續依每三年一次的頻率,再進行破壞去除效率檢測工作,以檢視破壞去除率是否高於 IPCC 及 USEPA Reporting Rule預設值。

(三) 監測計畫其他要素:

本計畫監督程序如下:

1. 監督之目的:

為確保計畫每年度蒐集與計畫溫室氣體排放量與/或移除量皆依循相同準則與程序。

處理設備之破壞去除效率、電力、天然氣使用量,含氟及 N₂O 溫室氣體使用量由 台積電 FAB14B 廠區製程、設備及廠務提供。

3. 監督方法(包括估計、模擬、量測或計算方式):

本計畫之含氟及 N₂O 溫室氣體排放減量依據 2006 年版 IPCC 方式及 USEPA Reporting Rule 進行計算,減量設備所安裝之 Local scrubber 的 maintenance 依據本公司之 SOP 進行,所有蒐集的監測資料於計入期結束後至少保存 2 年。

4. 監督時間與期間:

本計畫監督時間自民國 109 年 11 月起,至民國 119 年 11 月止。

5. 監督角色與責任:

公司工安環保部門擔任公司召集單位。廠區工安環保部門擔任廠區召集單位,負責 進行 GHG 盤查、數據蒐集、排放量計算等。廠區蝕刻、化學/物理氣相沉積、薄膜 及擴散製程設備及廠務部門擔任推行單位,負責執行機台設備運轉、維護、校正、 數據提供等。

6. 溫室氣體資訊管理系統:

公司訂有溫室氣體盤查管理程序,廠區環安部門擔任廠區召集人,自廠區設備部門收集相關數據進行溫室氣體排放量盤查,並彙整至公司工安環保部門,以進行外部查證。相關係數及盤查表格由公司工安環保部門統一提供。

五、專案活動期程描述:

(一)專案活動執行期間:

專案起始日為第一台削減設備裝機時間,民國 103 年 6 月 5 日(各別削減設備以實際其設備裝機時間為準)。部分設備為台積電他廠移入,最早於民國 101 年購置,故裝設日期較民國 103 年 6 月 5 日早,但專案起始日仍以實際使用於 FAB14 的第一台設備裝機

時間民國103年6月5日為主。

(二)專案計入期:

本減量專案為非林業之固定型,計入期為民國109年11月2日~119年11月1日。

六、環境衝擊分析:

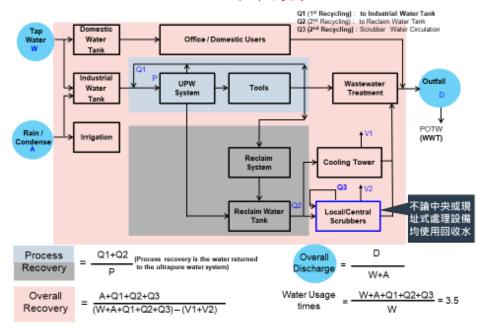
本專案係在廠內執行所有活動,其影響到其它環境的衝擊非常低。而參照類似減量方法(TM001)與已通過申請專案中表示,裝設 LS 將增加裝設環境之安全風險,有可能之局部性環境衝擊或安全風險包含:

- 1. 設備進廠前審查需符合半導體設備安全認證 SEMI Code 之要求,設備全程負壓抽氣,並搭配相關壓力表頭及環境偵測裝置,將廢氣逸散可能性降至最低。
- 2. 設備本體的壓力、溫度、洗滌水的監測,設置相關 interlock、EMO 按鈕,當超過警報設定值後,設備將部分停止或關閉,並搭配定期維護保養,確保功能正常。
- 3. 設備的安裝測試造成廠內噪音增加,影響員工的舒適感覺,本公司提供必要之 防護具及隔離設施,降低員工之噪音。
- 4. 設備的安裝所產生之事業廢棄物,增加事業廢棄物之產出量,本公司依法委託 合格之事業廢棄物清除、處理廠商處理,並盡可能尋求再利用處理途徑。
- 5. 水洗部分的水源來自製程回水(Local scrubber Reclaimed, LSR),並未額外使用自來水。故增設破壞削減設備後,對水資源耗用幾乎沒有衝擊;惟破壞削減設備之水洗除汙功能會增加些許水污染物質,然而這些汙染物皆在原本廢水處理系統可處理之餘裕下,對環境之衝擊相當有限。

這些環境衝擊,本專案在執行時將會考慮減少對環境的衝擊至最小,並設置相關防 護措施。



TSMC 水平衡圖



七、公眾意見描述:

評估此專案相關的族群為 LSC 原廠廠商、LSC 廠內維護人員、抵換專案參與人員, 及非抵換專案參與人員, 經電話調查及服務廠商溝通了解對本計畫執行的建議, 分成三種群體,除了非抵換專案參與人員範圍較大,隨機挑選善化區超商店員共5人訪談,其餘專案相關族群全數以電訪與訪談調查,訪談問題詳見附件五。

- 1. LSC 原廠廠商 (共 6 人,抽樣 100%): 裝設 LSC 除了企業社會責任,還能實質 獲得國家碳權獎勵,增加對 LSC 保養維護的重視,可以達到永續減排的目標。
- 2. LSC 工程人員(共 33 人,抽樣 100%):維護 LSC 正常運轉,不只對公司有幫助,也能減少溫室氣體對環境的危害,工作起來多了一份成就感。
- 3. 抵換專案參與人員(共 15 人,抽樣 100%):國家鼓勵自主安裝 LSC 的企業,予以碳權獎勵,是對企業節能減碳努力的肯定,期待後續申請成果。
- 4. 非參與抵換專案人員(鄰近居民共5人): 在沒有法規要求與環評承諾下,還願意 花這麼多前設置去除含氟氣體污染的設備,真的很不容易。讓我們在南科工作 的人員可以有好一點的空氣,自主性的減排作為,值得肯定。

以上皆為正面意見,本廠將會積極地完成此專案,公眾沒有負面意見須討論。

附件一 參與機構基本資料

單位名稱	台灣積體電路製造股份有限公司 FAB14B 廠		
統一編號	22099131		
單位地址	台南市善化區南科九路 17 號		
負責人姓名	蘇斌嘉	聯絡人姓名	莊雅鈞
傳真	(06) 505-5217	聯絡電話	0978-280980
電子信箱	ycjuangj@tsmc.com		